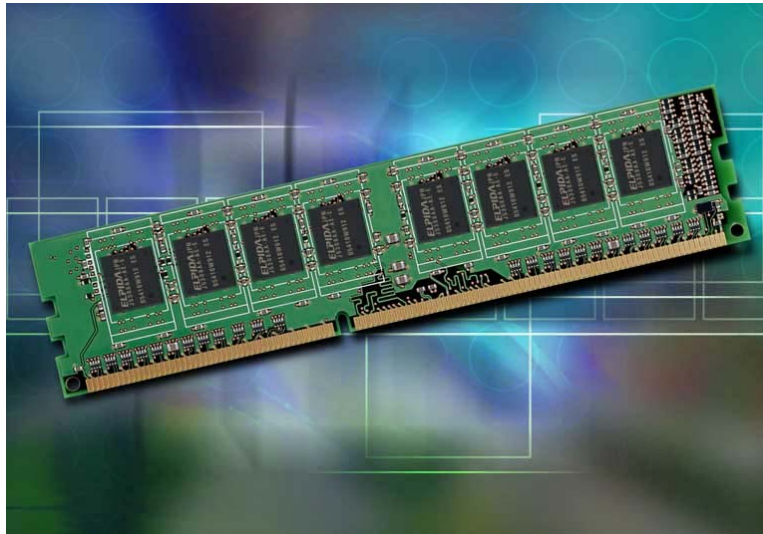


2005 年 11 月 14 日

512M ビット DDR3 SDRAM サンプル出荷開始

インテルへ DDR3 SDRAM 搭載 ギガヘルツ級高速 DIMM サンプルを出荷



エルピーダメモリ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：坂本幸雄以下、エルピーダ）は、このたび、本年 8 月に開発を完了した次世代の高速 DRAM、512M ビット DDR3 SDRAM の社内評価を終え、市場への投入を踏まえたサンプル出荷を開始しました。

今回、インテルへ出荷したのは、DDR3 SDRAM を搭載したモジュール：DIMM（Dual Inline Memory Module）形態です。

モジュール形態でのサンプル出荷を開始したことは、DDR3 のユーザである機器メーカーにおけるシステムレベルでの評価を可能にするものです。ギガヘルツ級の高速動作確認や、DDR3 とその周辺回路との高速インターフェース評価などができ、ユーザにおける評価環境拡大に大きく貢献します。

このたび出荷した DDR3 SDRAM DIMM の特長を以下に記します。

- ・モジュール形態の採用
 - DDR3 のユーザである機器メーカーにおけるシステムレベルでの評価に対応。
 - 次世代のサーバやハイエンド PC をはじめとする高性能コンピュータシステムの

開発に貢献。

- ・ギガヘルツ級の高速性能
 - 1066MHzでの動作を確認した512MビットDDR3 SDRAMを搭載し、モジュールにおいてもギガヘルツ級の高速性能を実現。システム上で高速動作確認が可能。
- ・システム上で、DDR3新機能の評価が可能
 - DDR3とその周辺回路間の高速伝送特性向上を実現する、出力強度や終端抵抗を自己調整/自己補正する機能。システム構成やシステム側の要求仕様に合わせて高精度かつフレキシブルに対応するもの。

また、DIMMに搭載した512MビットDDR3 SDRAMにおいては以下の特性を確認しています。

- ・低電圧1.5V動作で1066Mbpsの高速データ転送を実現
 - 動作電圧1.8VのDDR2-533(データ転送速度533Mbps)と比較すると2倍
- ・2倍の高速性能ながらDDR2製品と同等の消費電流
 - 動作電圧1.8VのDDR2と比較すると、消費電力は17%減

エルピーダでは、DDR3 SDRAM市場の立ち上がりにあわせた量産開始を目指し、さらに準備を進めてまいります。

以 上

ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。